

2SA638[Ⓢ], 2SA639[Ⓢ]

PNP エピタキシャル形シリコントランジスタ(アルミナパシベーション形)／

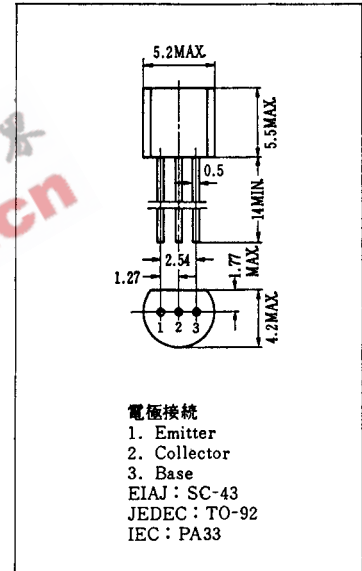
PNP SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR(Alumina Passivation)

表示管駆動, 高耐圧スイッチング用／Nixie Tube Driver, High Voltage Switching

工業用[Ⓢ]シリーズ／Industrial Use, Series[Ⓢ]

特 徴／FEATURES

- ・計数表示管などのダイナミック駆動回路に最適です。
Suitable for display tube dynamic drive circuit.
- ・耐圧が高い。2SA638[Ⓢ] BV_{CER} : -150V
2SA639[Ⓢ] BV_{CER} : -180V
High breakdown voltage.
- ・直流電流増幅率の線形リニアリティがよい。
Good linearity of DC current gain.

外形図／PACKAGE DIMENSIONS
(Unit:mm)絶対最大定格／ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	2SA638 [Ⓢ]	2SA639 [Ⓢ]	単 位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	-150	-180	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CER}^*	-150	-180	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5.0		V
コレクタ電流	I_C	-50		mA
全損失	P_T		250	mW
ジャンクション温度	T_J		125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}		-55~+125	$^\circ\text{C}$

* $R_{BE}=30\text{k}\Omega$ 電気的特性／ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-100\text{V}, I_E=0$			-1.0	μA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB}=-3.0\text{V}, I_C=0$			-1.0	μA
2SA638 [Ⓢ] コレクタ・エミッタ間降伏電圧	BV_{CER}	$I_C=-100\mu\text{A}, R_{BE}=30\text{k}\Omega$	-150	-240		V
2SA639 [Ⓢ] コレクタ・エミッタ間降伏電圧	BV_{CER}	$I_C=-100\mu\text{A}, R_{BE}=30\text{k}\Omega$	-180	-300		V
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE}=-3.0\text{V}, I_C=-1.0\text{mA}$	50	120		
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE}=-6.0\text{V}, I_C=-15\text{mA}$	30	100	330	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-10\text{mA}, I_E=-1.0\text{mA}$	-0.22	-0.90		V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=-10\text{mA}, I_B=-1.0\text{mA}$	-0.75	-1.00		V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=-10\text{V}, I_E=10\text{mA}$		130		MHz
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{V}, I_E=0, f=1.0\text{MHz}$		4.5		pF

 h_{FE} 区分/ h_{FE} Classification $h_{FE2}/30\sim130$ $100\sim220$ $150\sim330$